



Транзистор 2Т630

ОКП 63 41

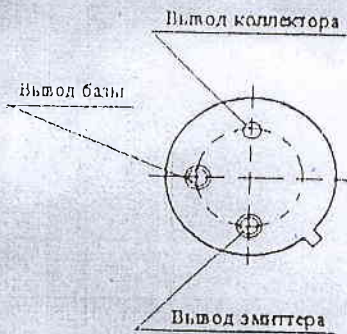
ЭТИКЕТКА

ЮФЗ.365.043 ЭТ

Кремниевые планарные n-p-n транзисторы типов 2Т630А, 2Т630Б в металlostеклянном корпусе КТ-2-7 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах. Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Сертификат ЦОС "Воснэлектронсерт"
Филиал ФБУ "46 ЦНИИ Минобороны России"
№ СВС.01.431.0337.11

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при $t_{\text{кр}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{\text{кз}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{к}} = 150 \text{ мА}$) 2Т630А 2Т630Б	$h_{21\text{э}}$	40	120
		80	240
Обратный ток коллектор-эмиттер, ($U_{\text{кз}} = 90 \text{ В}$, $R_{\text{кз}} \leq 3 \text{ кОм}$), мкА	$I_{\text{кэб}}$		1
Обратный ток эмиттера, ($U_{\text{эб}} = 5 \text{ В}$), мкА	$I_{\text{эбо}}$		0,1
Граничное напряжение, ($I_{\text{к}} = 30 \text{ мА}$, $Q \geq 200$, $\tau_{\text{н}} \leq 100 \text{ мкс}$), В 2Т630А 2Т630Б	$U_{\text{кэб гр}}$	90	
		80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_{\text{к}} = 150 \text{ мА}$, $I_{\text{э}} = 15 \text{ мА}$), В	$U_{\text{кэб нас}}$		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер, ($I_{\text{б}} = 150 \text{ мА}$, $I_{\text{э}} = 15 \text{ мА}$), В	$U_{\text{бэ нас}}$		1,1
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, ($I_{\text{к}} = 100 \text{ мкА}$, $R_{\text{кз}} = 3 \text{ кОм}$), В	$U_{\text{кэб проб}}$	120	
Пробивное напряжение эмиттер-база, ($I_{\text{э}} = 100 \text{ мкА}$), В	$U_{\text{эбо проб}}$	7	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото 13,6736 г

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 80000 ч, а в облегченных режимах и условиях при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений - 100000 ч при температуре окружающей среды не более 25°C.

2.2 Гамма-процентный ресурс при $T_{\text{у}} = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 160000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированием воздуха, а также транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру, или в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке предприятия-поставщика в неотапливаемых хранилищах и под навесом, а также смонтированными в аппаратуру незащищенных объектов, сроки сохраняемости соответствуют ГОСТ В 22468-77.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям ЮФЗ.365.043 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления.

Гарантийная наработка:

80000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ
100000 ч - в облегченном режиме

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т630А, 2Т630Б соответствуют техническим условиям ЮФЗ.365.043 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 121 от 21.01.15 дата

Место для штампа СКК

ОТК	12
18	

 Место для штампа ВП

Место для штампа "Пере проверка произведена" дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа СКК Место для штампа ВП

Цена договорная